

**B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가가 Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub> 세라믹스의 소성거동과 고주파 유전특성에 미치는 영향****Effect of B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> addition on the Sintering Behavior and Microwave Dielectric Properties of Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub> Ceramics**

**김민한, 남산, 유명재,\* 이우성,\* 박종철,\* 이학주\*\***

고려대학교 재료공학과

\*전자부품연구원

\*\*한국표준과학연구원

B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가가 Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub> 세라믹스의 소성거동과 유전특성에 미치는 영향을 고찰하였다. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 첨가로 인해 Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub> 세라믹스의 적정 소결온도는 850°C에서 740°C까지 낮아졌다 XRD 결과 모든 소결체는 sillenite 구조를 가지고 있었으며, 이차상은 발견되지 않았다. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>가 20 m/o 첨가되었을 때 500°C에서부터 급격한 수축을 나타내었다. B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 첨가에 따라 유전율과 공진주파수 온도계수는 점차 감소하였다. Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>+20 m/o B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 세라믹스는 800°C에서 2시간동안 소결할 경우  $\epsilon_r=31.5$ , Qxf=8400 GHz,  $\tau_f=-27 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$ , Bi<sub>12</sub>SiO<sub>20</sub>+2 m/o B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 세라믹스는 740°C에서 2시간동안 소결할 경우  $\epsilon_r=39$ , Qxf=7200 GHz,  $\tau_f=-21 \text{ ppm}^{\circ}\text{C}$ 의 유전특성을 나타내었다.

**전기장하의 BaTiO<sub>3</sub>의 결함과 확산거동을 조사하기 위한 임피던스분석****Impedance Analysis on Barium Titanite Single Crystal Under an Electric Field for Investigating its Defect Chemistry and Diffusion Mechanism**

**김동환, 한주환**

영남대학교 무기재료공학과 대학원

임피던스분석은 재료와 계면의 전기적 특성을 조사하는 새롭고 유용한 분석방법인데, 고체재료의 벌크나 계면에서 구속되어 있거나 움직이는 전하의 움직임을 조사하는 방식이다. 본 연구에서는 BaTiO<sub>3</sub> 단결정의 전기적특성을 임피던스 측정장치를 이용하여 알아보고자 하였는데, 임피던스 측정장치에 부착된 dielectric interface(1296 Dielectric Interface)를 사용함으로써, 실온에서 전기저항이 큰 세라믹스 재료의 전기적특성의 측정이 가능하였다. 시편의 준비과정은, 하나의 시편은 양면을 연마하였고 다른 것은 연마한 두 면이 맞닿도록하여 일축가압하면서 열처리하여(1360°C, 3 h) 접합된 시편을 제조하였다. 시편과 전극이 전기적으로 ohmic 접촉을 이루고, 물리적으로 접촉이 잘 되도록 silver paste로 전극을 형성한 후 aging(600°C, 1 h)하였다. 하나의 단결정과 접합된 단결정의 전기적특성을 비교하기위해 임피던스 분석장치(1260 Solartron Frequency Response Analyser)를 이용하여 실온(20°C)에서 주파수 범위 10<sup>-4</sup> Hz부터 10<sup>7</sup>까지 측정을 실시하여 결과를 비교하였다.